







	<h2>SIR330DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR330DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR330DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16149 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR330DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16149 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 35A (Tc) 5W (Ta), 27.7W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 27.7W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.6 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SIR330DP-T1-GE3-ND

SIR330DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR330DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR330DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR330DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR323-5 Everlight Electronics EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR330DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR333-A Everlight Electronics EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR333C EVERLIG EVERLIG DIP-2</p>
 <p>SIR401DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 50A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR383 Everlight Electronics EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>	 <p>SIR330DP-T1-E3 VISHAY SIR330DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR383C Everlight Electronics EMITTER IR 875NM 100MA RADIAL</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIR-59SSTA47	↔ SIR11-21C/TR8	⇒ SIR15-21C/TR8	D SIR158DP	↔ SIR158DP-T1-E3
↳ SIR158DP-T1-GE3	⊛ SIR158DP-T1-GE3	D SiR164ADP-T1-GE3	⇒ SIR164DP	↔ SIR164DP-T1-E3
⊛ SIR164DP-T1-GE3	↳ SIR164DP-T1-GE3	⊛ SIR166DP	↔ SIR166DP-T1-E3	↔ SIR166DP-T1-GE3
D SIR166DP-T1-GE3	⊛ SIR168DP	↳ SIR168DP-T1-GE3	⊛ SIR168DP-T1-GE3	↔ SIR172ADP-T1-GE3
⇒ SIR172ADP-T1-GE3	↔ SIR172DP	⊛ SIR172DP-T1-E3	↳ SIR172DP-T1-GE3	↔ SIR172DP-T1-GE3
↔ SIR330DP-T1-GE3	⇒ SIR402DP-T1-GE3	D SIR402DP-T1-GE3	⊛ SIR403EDP-T1-GE3	↳ SIR403EDP-T1-GE3
⊛ SIR404DP	D SiR404DP-T1-E3	⇒ SIR404DP-T1-GE3	↔ SIR404DP-T1-GE3	↔ SIR406DP
↳ SIR406DP-T1-E3	⊛ SIR406DP-T1-GE3	↔ SIR406DP-T1-GE3	⇒ SIR406DP-T1-GE3-S	↔ SIR408DP-T1-GE3
⊛ SIR408DP-T1-GE3	↳ SiR410DP-T1-E3	⊛ SIR410DP-T1-GE3	D SIR410DP-T1-GE3	↔ SiR412DP
↔ SiR412DP-T1-E3	⊛ SIR412DP-T1-GE3	↳ SIR412DP-T1-GE3	⊛ SIR414DP	↔ SIR414DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited